W055,667

PATENT

Notice of Allowance Date: N/A

Batch No.: Unknown

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Serial No .: 10/055,667 Examiner: Unknown

Filed: Group Art Unit: January 22, 2002 Title:

1771 ALIGNED FINE PARTICLES, METHOD FOR PRODUCING THE SAME

AND DEVICE USING THE SAME

CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.8: The undersigned hereby certifies that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service, as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Name: Todd Michel

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Assistant Commissioner for Patents

MAY 1 0 2002

Washington, D.C. 20231

TC 1700

Dear Sir:

× ,.

Applicants enclose herewith, certified copies of Japanese applications, Serial No. 2001-015380, filed January 24, 2001, Serial No. 2001-015382, filed January 24, 2001, Serial No. 2001-128874, filed April 26, 2001, and Serial No. 2001-283300, filed September 18, 2001, the right of priority of which is claimed under 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

MERCHANT & GOULD P.C. P.O. Box 2903

Minneapolis, Minnesota 55402-0903 (612) 332-5300

Dated: May 2, 2002

DPM/tvm

Donglas P. Mueller

Reg. No. 30,300



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年 1月24日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-015380

[ST.10/C]:

[JP2001-015380]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

RECEIVED
TC 1700

2002年 1月18日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





特2001-015380

【書類名】

特許願

【整理番号】

2033730002

【提出日】

平成13年 1月24日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B22F 1/02

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

美濃 規央

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】

松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】

岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康・

【選任した代理人】

【識別番号】

100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

特2001-015380

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 微粒子からなる構造物の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 微粒子表面に有機コーティング膜を形成し、支持基板表面に有機コーティング膜を形成し、前記微粒子表面の有機コーティング膜と前記支持基板表面の有機コーティング膜と前記支持基板表面の有機コーティング膜の間で化学結合を形成させることを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項2】 支持基板表面と微粒子表面に有機コーティング膜を形成し、微粒子表面の有機コーティング膜と支持基板表面の有機コーティング膜とを接触させ、双方の有機コーティング膜の間で化学結合を形成させ、支持基板表面上に第一の微粒子からなる構造物を形成した後に、前記支持基板上に形成した第一の微粒子からなる構造物を構成する微粒子表面の有機コーティング膜に、新たな有機コーティング膜を有する微粒子を接触させ、双方の有機コーティング膜の間で化学結合を形成させて、第二の微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項3】 支持基板上に形成された有機コーティング膜にエネルギー線を 照射することにより、前記エネルギー線が照射された部分の有機コーティング膜 に化学反応基を発生させた後に微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結 合を形成させることを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項4】 支持基板上に形成された有機コーティング膜にエネルギー線を 照射することにより照射された部分の有機コーティング膜を除去せしめることに より支持基板表面の残余部分の有機コーティング膜と微粒子表面の有機コーティ ング膜との間で化学結合を形成させることを特徴とする微粒子からなる構造物の 形成方法。

【請求項5】 支持基板上に微粒子をからなる構造物を形成する方法において、支持基板表面に形成された有機コーティング膜にエネルギー線を照射することにより照射された部分の有機コーティング膜に化学反応基を発生させて微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成させて、エネルギー線照射部分にのみ微粒子からなる構造物を形成した後、エネルギー線を照射しなかった部分

に新たなエネルギー線を照射し、当該照射された部分の有機コーティング膜に化学反応基を発生させ、当初形成された微粒子からなる構造物を構成する微粒子とは別種の微粒子を支持基板表面に接触せしめて微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成させることを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項6】 支持基板上に微粒子をからなる構造物を形成する方法において、支持基板表面に形成された有機コーティング膜にエネルギー線を照射することにより照射された部分の有機コーティング膜を除去せしめることにより支持基板表面の残余部分の有機コーティング膜と微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成させてエネルギー線非照射部分に微粒子からなる構造物を形成した後、再度支持基板表面に有機コーティングからなる構造物を形成し、新たに支持基板表面に形成された有機コーティング膜と当初形成された微粒子総攻勢微粒子とは別種の微粒子を支持基板表面に接触せしめて微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成させることを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項7】 支持基板上に微粒子をからなる構造物を形成する方法において、支持基板表面に形成された有機コーティング膜と微粒子表面に形成された有機コーティング膜を接触せしめ、化学結合を形成した後、微粒子表面の有機コーティング膜に重合操作を施して有機コーティング膜の分子数を増大させることを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項8】 支持基板上に微粒子をからなる構造物を形成する方法において、支持基板上に請求項1または請求項2の方法により微粒子からなる構造物を形成した後に、当該基板にエネルギー線を照射することにより照射した箇所の微粒子からなる構造物を除去せしめたことを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項9】 微粒子表面に形成した有機コーティング膜と支持基板表面の有機コーティング膜間の化学結合が共有結合、イオン結合、配位結合、分子間力のいずれかである請求項1から8記載の微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項10】 有機コーティング膜が単分子膜または単分子膜を出発材料と

した重合膜である請求項1から8記載の微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項11】 単分子膜がセルフアセンブル膜でチオール基、クロロシラン基、配位結合基、イソシアネート基、アルコキシシラン基を有する分子から形成される請求項1から8記載の徴粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項12】 微粒子を構成する材質が金属、金属酸化物、両性元素、両性元素酸化物、樹脂、またはこれらの複数の複合体、化合物である請求項1から8 記載の微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項13】 支持基板を構成する材質が金属、金属酸化物、両性元素、両性元素酸化物、樹脂、またはこれらの複数材料の複合体、化合物である請求項1から8記載の微粒子からなる構造物の形成方法。

【請求項14】 エネルギー線が紫外線、遠紫外線、X線、ガンマ線またはプラズマ励起である請求項1から8記載の微粒子からなる構造物の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は微粒子表面に有機コーティング膜を形成させた上で基板表面上に微粒子のからなる構造物を形成する方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来の代表的な微粒子を有する基板の形成技術としては、溶液に分散させた微粒子溶液に基板を浸漬させる方法、基板表面に前記微粒子を滴下し、バーコートする方法、同じく前記微粒子溶液を基板表面に滴下した後に回転塗布して表面に塗布する方法などがある。

[0003]

また、数年前から微粒子表面に有機薄膜を形成する方法が開発されている。特 開平1-309902号公報にはクロロシラン系化合物などを用いた有機材料で 微粒子の表面を覆う方法が開示され、基板表面に微粒子からなる膜を形成する方 法が示されている。

[0004]

また、最近、科学雑誌サイエンス(Science、2000年3月17日号)にも徴粒子表面に単分子膜様の膜を形成し、基板表面に形成させたとの報告がある。

[0005]

また、特開平2-9196号公報では微粒子のパターン形成方法が開示されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の代表的な形成技術である溶液に分散させた微粒子溶液に基板を 浸漬させる方法、基板表面に前記微粒子を滴下し、バーコートする方法、同じく 前記微粒子溶液を基板表面に滴下した後に回転塗布して表面に塗布する方法のい ずれの方法も微粒子径の単位で微粒子の膜厚を制御することができないものであ り、微粒子径が小さくなればなるほど基板表面の微粒子の膜厚分布は大きくなる ものである。

[0007]

また、上記特願昭63-139978は微粒子表面を単分子膜で覆う基本特許 として価値あるものであるが、基板表面に微粒子を固定する方法が開示されてお らず、実用面、製造面また耐久性で問題があると推測される。

[0008]

また、上記報告 (Science、2000年3月17日号) によると微粒子からなる膜の厚みを制御する方法が確立されておらず、また前記特許と同様に基板表面に微粒子を置いただけで、基板と微粒子との密着性に問題があり、実用面製造面また耐久性で大きな問題がある。

[0009]

また、従来の方法では一種類の微粒子による形成だけであった。

·[0010]

しかし、機能性デバイスを実現するためには一種類の微粒子だけでなく、複数 の種類の微粒子が必要である。

[0011]

従来の技術ではそのような方法の開示はなく、想定もしていなかった。

[0012]

また、特開平1-309902号公報に記載の発明では微粒子のパターンを形成する方法としては一手法が示されているが、上記先行技術と同じく微粒子と基板との結合に関しては開示されておらず、実用面、製造面また耐久性ではまだまだ問題がある。

[0013]

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するため本発明は、微粒子表面に有機コーティング膜を形成した微粒子を支持基板上に配列せしめる方法において、支持基板表面にも有機コーティング膜を形成させ、微粒子表面の有機コーティング膜と支持基板表面の有機コーティング膜とを接触せしめ、双方の有機コーティング膜の間で化学結合を形成させることを特徴とする。

[0014]

次に本発明の第二番目の徴粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板表面と 微粒子表面に有機コーティング膜を形成し、微粒子表面の有機コーティング膜と 支持基板表面の有機コーティング膜とを接触せしめて、双方の有機コーティング 膜の間で化学結合を形成させ、支持基板表面上に第一の微粒子からなる構造物を 形成した後に、当該支持基板上に形成した第一の微粒子からなる構造物を構成す る微粒子表面の有機コーティング膜に、新たな有機コーティング膜を有する微粒 子を接触せしめ、双方の有機コーティング膜の間で化学結合を形成させて、第二 の微粒子からなる構造物の形成することを特徴とする微粒子からなる構造物の形 成方法、また上記工程を繰り返すことにより第三またはそれ以上の微粒子からな る構造物を形成することを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法。

[0015]

次に本発明の第三番目の微粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板上に形成された有機コーティング膜にエネルギー線を照射することにより照射された部分の有機コーティング膜に化学反応基を発生させた後に微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成させることを特徴とする。

[0016]

次に本発明の第四番目の微粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板上に形成された有機コーティング膜にエネルギー線を照射することにより照射された部分の有機コーティング膜を除去せしめることにより支持基板表面の残余部分の有機コーティング膜と微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成させることを特徴とする。

[0017]

次に本発明の第五番目の微粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板表面に 形成された有機コーティング膜にエネルギー線を照射することにより照射された 部分の有機コーティング膜に化学反応基を発生させた後に微粒子表面の有機コー ティング膜との間で化学結合を形成させて、エネルギー線照射部分にのみ微粒子 からなる構造物を形成した後、エネルギー線を照射しなかった部分に新たなエネ ルギー線を照射し、当該照射された部分の有機コーティング膜に化学反応基を発 生させ、当初形成された微粒子からなる構造物を構成する微粒子とは別種の微粒 子を支持基板表面に接触せしめて微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学 結合を形成させることを特徴とする。

[0018]

次に本発明の第六番目の微粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板表面に 形成された有機コーティング膜にエネルギー線を照射することにより照射された 部分の有機コーティング膜を除去せしめることにより支持基板表面の残余部分の 有機コーティング膜と微粒子表面の有機コーティング膜との間で化学結合を形成 させてエネルギー線非照射部分に微粒子からなる構造物を形成した後、再度支持 基板表面に有機コーティングからなる構造物を形成し、新たに支持基板表面に形 成された有機コーティング膜と当初形成された微粒子総攻勢微粒子とは別種の微 粒子を支持基板表面に接触せしめて微粒子表面の有機コーティング膜との間で化 学結合を形成させることを特徴とする。

[0019]

次に本発明の第七番目の微粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板表面に 形成された有機コーティング膜と微粒子表面に形成された有機コーティング膜を 接触せしめ、化学結合を形成した後、微粒子表面の有機コーティング膜に重合操作を加える有機コーティング膜の分子数を増大させることを特徴とする。

[0020]

次に本発明の第八番目の微粒子からなる構造物の形成方法は、支持基板上に微粒子をからなる構造物を形成する方法において、支持基板上に本発明の第一番目の微粒子からなる構造物の形成方法または本発明の第二番目の微粒子からなる構造物の形成方法により微粒子からなる構造物を形成した後に、当該基板にエネルギー線を照射することにより照射した箇所の微粒子からなる構造物を除去せしめたことを特徴とする微粒子からなる構造物の形成方法である。

[0021]

【発明の実施の形態】

微粒子表面に形成した有機コーティング膜と支持基板表面の有機コーティング膜間の化学結合は共有結合、イオン結合、配位結合、分子間力のなかから形成される。そのため微粒子と基板とは結合され、従来の技術で課題であった実用面、製造面また耐久性で問題が解決される。さらに、必要に応じて微粒子同士間での結合も行われるので、このときも実用面、製造面また耐久性で問題が解決される

[0022]

また、有機コーティング膜が単分子膜または単分子膜を出発材料とした重合膜であるので、微粒子の間隔が制御することが可能となる。

[0023]

また、単分子膜がセルフアセンブル膜でチオール基、クロロシラン基、配位結合基、イソシアネート基、アルコキシシラン基を有する分子から形成されるので、微粒子の素材に応じた有機コーティング膜形成が可能となり、微粒子と有機コーティング膜を構成する分子との間に化学結合が形成されるため実用面、製造面また耐久性で問題が解決される。

[0024]

また、徴粒子を構成する材質が金属、金属酸化物、両性元素、両性元素酸化物 、樹脂、またはこれらの複数の複合体、化合物であるので、多様な機能性能の要 求に応じた基板と結合した微粒子からなる構造物の形成が可能となる。

[0025]

また、支持基板を構成する材質が金属、金属酸化物、両性元素、両性元素酸化物、樹脂、またはこれらの複数材料の複合体、化合物であるので、多様な機能性能の要求に応じた基板と結合した微粒子からなる構造物の形成が可能となる。

[0026]

また、エネルギー線が紫外線、遠紫外線、X線、ガンマ線で使用可能であるので、有機コーティング膜を構成する多様な官能基を使用することが可能となる。

[0027]

また、エネルギー線としてプラズマを使うことにより容易に化学反応基を発生 させることもでき、本方式によっても有機コーティング膜を構成する多様な官能 基を使用することが可能となる。

[0028]

また、本発明で使用することが出来る化合物としては、下記のものを例示することが出来る。

[0029]

以下に、本発明の微粒子からなる構造物構造形成の具体的実施例を説明する。

[0030]

(実施例1)

乾燥雰囲気で非水系不活性溶媒としてヘキサン100mLに末端官能基としてフェニル基を有するクロロシラン化合物を加えて0.01mo1/Lのヘキサン溶液を作成した。次にその溶液に磁性微粒子1を100mg加え、よく攪拌した。半時間後に当該乾燥雰囲気で上記ヘキサン溶媒及び未反応のクロロシラン化合物と磁性微粒子を分離した。この操作により磁性微粒子表面上に上記クロロシラン化合物からなる単分子膜2が形成された(図1)。

[0031]

一方、乾燥雰囲気でヘキサデカンとクロロホルムの容積比4対1の溶媒を作成し、当該溶媒100mLに末端官能基としてCH₂C1基を有するクロロシラン化合物を加えて0.01mo1/Lのヘキサデカン/クロロホルム混合溶液を作

成した。乾燥雰囲気でこの溶液20mLを採り、磁性微粒子を保持するシリコン基板3を上記溶液に浸漬し、緩やかに攪拌した。半時間後に同じく乾燥雰囲気で上記混合溶液から上記基板を取り出し、乾燥雰囲気で上記基板をクロロホルムに浸漬して洗浄を行った。その後、上記基板3を取り出した。基板表面上には上記クロロシラン化合物からなる単分子膜4が形成された。

[0032]

次に、上記基板表面に上記磁性微粒子を保持する操作を行った。上記単分子膜 形成を終えた磁性微粒子をクロロホルムに分散させた液を調整した。その濃度は 適宜でよく、本実施例の場合はクロロホルム50mLに対して100mgとした 。上記基板を入れたマイクロ反応容器を油浴に置き、上記基板上にスポイトを用 いて上記クロロホルム溶液を数箇所滴下して、基板表面が上記クロロホルム溶液 で濡れた状態にした。さらに塩化アルミニウムをごく少量加えて、攪拌子により よく撹拌した。次いで油浴の温度を上げて、120度程度に設定し、加熱した。 基板上のクロロホルムはすぐに気化するのでそれを抑えるためマイクロ反応容器 に冷却管を取り付けてクロロホルム溶液の減少を抑えた。1時間後、基板上には 磁性微粒子が残り、磁性微粒子と基板の双方の表面に形成された単分子膜の官能 基同士の化学反応が行われた。この反応は基板表面に形成された単分子膜の官能 基と磁性微粒子表面に形成された単分子膜表面の官能基に対してのみ行われ、磁 性微粒子表面に形成された単分子膜の官能基同士では反応が起きず、反応後に基 板をヘキサンで洗うことにより未反応の磁性微粒子は基板から洗い落とすことが 出来、基板上には反応が起きた磁性微粒子が化学結合5で固定された。この磁性 微粒子は結果として基板表面上に微粒子からなる構造物6を形成した(図2)。 反応後は高解像度電子顕微鏡によりシリコン基板上に微粒子の膜の形成が行われ ていることを確認し、またクロロホルム、アセトンの溶剤により微粒子の膜がシ リコン基板から剥離しないことも上記の高解像度電子顕微鏡により確認した。な お、以下の実施例での評価も上記と同様の手法にて実施し、確認を行った。

[0033]

(実施例2)

乾燥雰囲気でブチルアルコール100mLに水酸基を末端官能基として有する

チオール化合物を加えて0.01mol/Lのブチルアルコール溶液を作成した。 次にその溶液に貴金属微粒子100mg(10)を加え、よく攪拌した。半時間 後に当該乾燥雰囲気で上記ブチルアルコールおよび未反応のチオール化合物と貴 金属微粒子を分離して、貴金属微粒子表面上に上記チオール化合物からなる単分 子膜11が形成された。

[0034]

一方、上記貴金属微粒子を保持する基板12に対しても単分子膜形成操作を行った。乾燥雰囲気でヘキサデカンとクロロホルムの容積比4対1の溶媒を作成し、当該溶媒100mLにエポキシ基を末端官能基を有するクロロシラン化合物を加えて0.01mo1/Lのヘキサデカン/クロロホルム混合溶液を作成した。乾燥雰囲気でこの溶液20mLを採り、上記基板を上記溶液に浸漬し、緩やかに攪拌した。半時間後に同じく乾燥雰囲気で上記混合溶液から上記基板を取り出し、乾燥雰囲気で上記基板をクロロホルムに浸漬して洗浄を行った。その後、基板を取り出した。基板表面上には上記クロロシラン化合物からなる単分子膜13が形成された。

[0035]

次に、上記基板表面に上記貴金属微粒子を保持する操作を行った。上記単分子膜形成を終えた磁性微粒子をブチルアルコールに分散させた液を調整した。その濃度は適宜でよく、本実施例の場合はヘキサン50mLに対して100mgとした。上記基板をホットプレート上に置き、上記基板上にスポイトを用いて上記ブチルアルコール溶液を数箇所滴下して、基板表面が上記ブチルアルコール溶液で濡れた状態にした。次いでホットプレートの温度を上げて、150度程度に設定し、加熱した.基板上のブチルアルコールはすぐに気化し、基板上には貴金属微粒子が残り、貴金属微粒子と基板の双方の表面に形成された単分子膜の官能基同士の化学反応が行われた。この反応は基板表面に形成された単分子膜の官能基と貴金属微粒子表面に形成された単分子膜表面の官能基に対してだけ行われ、貴金属微粒子表面に形成された単分子膜の官能基同士では反応が起きず、反応後に基板をブチルアルコールで洗うことにより未反応の貴金属微粒子は基板から洗い落とすことが出来、基板上には反応が起きた貴金属微粒子が化学結合14で固定さ

れた。この貴金属微粒子は結果として基板表面上に微粒子からなる構造物 1 5 を 形成した(図 3)。

[0036]

(実施例3)

エチルアルコールを溶媒にして末端にアミノ基を官能基として有するメトキシシラン化合物の0.01モル溶液を作成した。この溶液50mLに磁性微粒子10mg(20)を加えて、緩やかに攪拌し、つぎに反応促進のため1M塩化水素水を1mL加えてさらに攪拌した。半時間後に固液分離を行って、磁性微粒子を取り出し、エチルアルコール100mL中に当該磁性微粒子約10mgを入れて、緩やかに攪拌して洗浄した。その後、再び固液分離を行って磁性微粒子を取り出した。次に当該磁性微粒子を120℃に設定したベーク装置に入れて、半時間静地した。これらの操作によって磁性微粒子表面にメトキシシラン化合物からなる単分子膜21が形成された。

[0037]

一方、磁性微粒子を保持する基材表面にも同様の処理を行い、単分子膜を形成した。エチルアルコールを溶媒にして末端にカルボキシル基を官能基として有するメトキシシラン化合物の0.01モル溶液を作成した。この溶液50mLをシャーレに採り、その溶液に塩化水素水を1mL加えた後に、2cm×3cmのシリコン基板22を浸漬し、およそ1時間静地した。次にシリコン基板を溶液から取り出し、エチルアルコールで数度基板表面を洗った。基板表面に乾燥窒素ガスを当てて基板表面を乾燥し、その後、120℃に維持したベーク装置に当該基板を入れて、半時間静地した。これらの操作を経てシリコン基板表面にメトキシシラン化合物からなる単分子膜23が形成された。

[0038]

次に、上記磁性微粒子およそ10mgをエチルアルコール10mLに加えて上 記単分子膜形成を終えた磁性微粒子をエチルアルコールに分散させた液を調整し た。その濃度は適宜でよい。上記基板をホットプレート上に置き、上記基板上に スポイトを用いて上記エチルアルコール溶液を数箇所滴下して、基板表面が上記 エチルアルコール溶液で濡れた状態にした。次いでホットプレートの温度を上げ て、150度程度に設定し、加熱した・基板上のエチルアルコールはすぐに気化し、基板上には磁性微粒子が残り、磁性微粒子と基板の双方の表面に形成された単分子膜の官能基同士の化学反応が行われた。この反応は基板表面に形成された単分子膜の官能基と磁性微粒子表面に形成された単分子膜表面の官能基に対してだけ行われ、磁性微粒子表面に形成された単分子幕の官能基同士では反応が起きず、反応後に基板をエチルアルコールで洗うことにより未反応の磁性微粒子は基板から洗い落とすことが出来、基板上には反応が起きた磁性微粒子が化学結合24で固定された。この磁性微粒子は結果として基板表面上に微粒子からなる構造物25を形成した(図4)。

[0039]

(実施例4)

実施例2に示すように、水酸基を末端官能基として有するチオール化合物からなる磁性微粒子30の表面上に上記単分子膜31を形成し、上記磁性微粒子を保持する基板32に対してもエポキシ基を末端官能基として有するクロロシラン化合物からなる単分子膜33が形成し、その後、上記基板表面に上記磁性微粒子を保持する化学結合反応の操作を行い、その結果、上記磁性微粒子は基板表面上で化学結合34を形成し、微粒子からなる構造物35を形成した(図5)。

[0040]

つぎに、乾燥雰囲気でヘキサデカンとクロロホルムの容積比4対1の溶媒を作成し、当該溶媒100mLにエポキシ基を末端官能基として有するクロロシラン化合物を加えて0.01mo1/Lのヘキサデカン/クロロホルム混合溶液を作成した。乾燥雰囲気でこの溶液20mLを採り、磁性微粒子36に上記溶液を接触させて、緩やかに攪拌した。半時間後に同じく乾燥雰囲気で上記混合溶液から上記微粒子の接触を終え、乾燥雰囲気で上記微粒子をクロロホルムに接触させて洗浄を行った。その後、上記微粒子を取り出した。一連の操作を終えて上記微粒子の表面上には上記クロロシラン化合物からなる単分子膜37が形成された。

[0041]

次に、上述の基板32の表面に磁性微粒子30を保持する操作を行った基板に 新たに今回作成した磁性微粒子35を接触させる操作を行った。上記単分子膜形 成を終えた磁性微粒子をブチルアルコールに分散させた液を調整した。その濃度は適宜でよく、本実施例の場合はヘキサン50mLに対して100mgとした。上記基板をホットプレート上に置き、上記基板上にスポイトを用いて上記ブチルアルコール溶液を数箇所滴下して、基板表面が上記ブチルアルコール溶液で濡れた状態にした。次いでホットプレートの温度を上げて、150度程度に設定し、加熱した、基板上のブチルアルコールはすぐに気化し、基板上には磁性微粒子が残り、先に基板上に形成された微粒子からなる構造物の磁性微粒子と今回単分子膜の処理を行った微粒子の表面に形成された単分子膜の官能基同士の化学反応が行われた。この反応は2種類の磁性微粒子表面に形成された単分子膜表面の官能基に対してだけ行われ、今回形成した磁性微粒子表面に形成された単分子膜の官能基と基板に形成されている単分子膜間では反応が起きず、反応後に基板をブチルアルコールで洗うことにより未反応の磁性微粒子は基板から洗い落とすことが出来、基板上には微粒子からなる構造物の微粒子と反応が起きた新しい磁性微粒子が化学結合38で固定された。結果として、この磁性微粒子は基板表面上に第二の微粒子からなる構造物39の構造を形成した(図6)。

[0042]

(実施例5)

実施例2に示す基板に形成した最初の単分子膜が微粒子表面に形成されている 微粒子からなる構造物35を用いて、実施例4にて形成された第二の微粒子から なる構造物39の形成が実施された基板に再度微粒子からなる構造物の形成を行 った。

[0043]

操作方法は実施例2に示す条件と同じにした。その結果、実施例4に示した第二の微粒子からなる構造物の微粒子からなる構造物の上に新たに第三の微粒子からなる構造物40を形成することが確認された(図7)。

[0044]

さらなる徴粒子の累積からなる構造物形成は実施していないが、同様の一連の 操作を繰り返すことにより任意の累積数の微粒子からなる構造物が形成できると 推測できる。

[0045]

また、異種の材料に微粒子の積からなる構造物構造も本方式により累積総数を 制御しながら形成できると推測される。

[0046]

(実施例6)

末端にハロゲン基(本実施例では臭素)を有するクロロシラン系材料をシリコーンオイルにおよそ1重量%の濃度になるように溶かした。この溶液100mLに対してシリコン系無機微粒子50を10g入れてよく攪拌したところ、シリコン系無機微粒子の表面でクロロシラン系材料が脱塩化水素反応を起こして、シリコン系無機微粒子の表面にクロロシラン系材料からなる単分子膜51が形成された。反応を終えた上記溶液から未反応クロロシラン系材料を含むシリコーンオイルを除き、さらに数度、多量のクロロホルムを加えてシリコン系微粒子を洗浄し、最後に反応を終えたシリコン系無機微粒子を得た。

[0047]

また、上記微粒子を置く基板となるガラス板52にも同様に不飽和結合基を有するクロロシラン系材料のシリコーンオイル溶液を作成し、この溶液にガラス板を接触させ、反応後のガラス板をクロロホルムで洗浄して、表面に単分子膜53が形成されたガラス板を得た。

[0048]

上記の単分子膜が形成されたガラス基板にエネルギー線としてX線を照射した。X線照射によりガラス基板上の単分子膜の不飽和結合基は励起され、反応活性部位に変化した。直ちに上記単分子膜が形成されているシリコン系無機微粒子を基板表面に接触させたところガラス基板上の単分子膜とシリコン系無機微粒子表面の単分子膜が化学結合54を生じ、ガラス基板上にシリコン系無機微粒子が固定された。この化学結合は微粒子間では生じず、結果としてガラス基板上には微粒子からなる構造物のみを形成することが出来た(図8)。

[0049]

このエネルギー線照射を繰り返し行うことにより任意の微粒子からなる構造物 を形成できることが可能になる。 [0050]

(実施例7)

実施例1と同様に乾燥雰囲気で非水系不活性溶媒としてヘキサン100mLに 末端官能基としてフェニル基を有するクロロシラン化合物を加えて0.01mo 1/Lのヘキサン溶液を作成した。次にその溶液に磁性微粒子(60)100m gを加え、よく攪拌した。半時間後に当該乾燥雰囲気で上記ヘキサン溶媒及び未 反応のクロロシラン化合物と磁性微粒子を分離した。この操作により磁性微粒子 表面上に上記クロロシラン化合物からなる単分子膜61が形成された(図9)。

[0051]

一方、上記磁性微粒子を保持する基板62に対しても微粒子と同様の単分子膜 形成操作を行ない、末端官能基としてCH₂C1基を有する単分子膜を形成した 。乾燥雰囲気でヘキサデカンとクロロホルムの容積比4対1の溶媒を作成し、当 該溶媒100mLに末端官能基を有するクロロシラン化合物を加えて0.01m o1/Lのヘキサデカン/クロロホルム混合溶液を作成した。乾燥雰囲気でこの 溶液20mLを採り、上記基板を上記溶液に浸漬し、緩やかに攪拌した。半時間 後に同じく乾燥雰囲気で上記混合溶液から上記基板を取り出し、乾燥雰囲気で上 記基板をクロロホルムに浸漬して洗浄を行った。その後、基板を取り出した。基 板表面上には上記クロロシラン化合物からなる単分子膜63が形成された(図1 0)。

[0052]

次に、基板を金属マスクを介して500W高圧紫外線ランプ64下に置き、紫外線を照射した。30秒の照射により紫外線が照射された部分の基板上単分子膜は除去され、金属マスク65で覆われたところだけに単分子膜66が残った(図11)。

[0053]

次に、実施例1と同じく上記基板表面に上記磁性微粒子を保持する操作を行った。上記単分子膜形成を終えた磁性微粒子をクロロホルムに分散させた液を調整した。その濃度は適宜でよく、本実施例の場合はクロロホルム50mLに対して100mgとした。上記基板を入れたシャーレをホットプレート上に置き、上記

基板上にスポイトを用いて上記クロロホルム溶液を数箇所滴下して、基板表面が上記クロロホルム溶液で濡れた状態にした。さらに塩化アルミニウムをごく少量加えて、よく撹拌した。次いでホットプレートの温度を上げて、120度程度に設定し、加熱した。基板上のクロロホルムはすぐに気化するのでシャーレでふたをしてクロロホルムの減少を抑えた。1時間後、基板上には磁性微粒子が残り、磁性微粒子と基板の双方の表面に形成された単分子膜の官能基同士の化学反応が行われた。この反応は基板表面に金属マスクを介して形成された単分子膜の官能基と磁性微粒子表面に形成された単分子膜表面の官能基に対してのみ行われ、磁性微粒子表面に形成された単分子膜の官能基同士および紫外線照射された基板部分では反応が起きず、反応後に基板をヘキサンで洗うことにより未反応の磁性微粒子は基板から洗い落とすことが出来、基板上には反応が起きた磁性微粒子が化学結合67で固定された。この磁性微粒子は結果として基板表面上の金属マスクで覆われていた部分にのみに微粒子からなる構造物を形成した(図12)。

[0054]

(実施例8)

実施例7でパターン形成された微粒子からなる構造物70の基板に新たなクロロシラン材料を用いて微粒子からなる構造物が形成されなかった部分にのみ新たな単分子膜71を形成した。ヘキサデカンとクロロホルムの体積比4対1の混合液に濃度1%の末端二重結合のクロロシラン化合物の溶液を作成した。この溶液に先のパターン化された微粒子からなる構造物構造の基板を浸漬した。半時間後基板を取り出し、クロロホルムで洗浄を行った。以上の操作により実施例7で紫外線を照射することによって実施例7で単分子膜が除去された箇所に再度末端二重結合を有する単分子膜が形成された。なお、すでに微粒子のパターンが形成されているところの微粒子表面や基板上には新たな単分子膜の形成は認められなかった。よって選択的な単分子膜形成がなされたものと考えられる。

[0055]

ついで、上記基板に過マンガン酸カリウム水溶液を用いて単分子膜構成分子末端の二重結合の酸化処理を行った。約10時間の浸漬によって、二重結合部分はCOOH基に変化した。

[0056]

微粒子には貴金属微粒子72を用いた。末端アミノ基のチオール系材料をエチルアルコールに溶かし、そこに貴金属微粒子を入れ、24時間撹拌することにより貴金属微粒子表面にチオール材料による単分子膜73が形成された。

[0057]

上記基板と上記貴金属微粒子を用いて微粒子の基板上への固定操作を実施した。 ヘキサンに単分子膜を形成した貴金属微粒子を分散し、その液を基板に滴下し、 120℃で加熱処理した。この処置により貴金属微粒子の有機コーティング膜と基板表面の有機コーティング膜は化学結合 74を形成し、新たに貴金属粒子からなる構造物 75 が基板 62 に固定された(図13)。

[0058]

(実施例9)

実施例5で形成した3層構造の微粒子からなる構造物が形成された基板80に 金属マスクを介して電子線を照射した。その後、上記基板を四塩化炭素に浸漬し たところ電子線を照射した部分の微粒子からなる構造物は除去され、電子線が照 射されなかったところのみ微粒子からなる構造物が残り、基板上に微粒子からな る構造物のパターン81が形成された(図14)。

[0059]

なお、基板に形成する有機コーティング膜と微粒子に形成する有機コーティング膜の材料の系統を同じにする必要はなく、それぞれの材質などに合わせて適宜 選択すればよい。

[0060]

なお、実施例では磁性微粒子の例を多く示してあるが、何も磁性微粒子に限る 必要はなく、光学的、誘電的、電気的、量子的、強度的な性能を必要とする場合 はそれに代わる材料であっても良いことは言うまでもない。

[0061]

なお、実施例では熱工程を明記していないが、磁性的性質を出すために後工程 で熱処理を施すことがあることもある。

[0062]

なお、本実施例で示す化学結合の事例は一例であり、化学結合、特に共有結合 を形成する化学反応は非常に効果が大であることは言うまでもない。次にごく一 部であるが、実施例に示す以外の化学結合を形成する反応事例のみを列挙する。

[0063]

- ーアミノ基と-C1CO基反応系
- 一水酸基と-ROSi基反応系
- ーベンジル基とーアミノ基反応系
- ーベンジル基とーフェニル基反応系・
- ーアルデヒド基とーアミノ基反応系
- ーフェニル基とーアルキル基反応系
- ーフェニル基と一C1CO基反応系
- ーベンジル基とーベンゾアルデヒド基反応系
- ーイソシアネート基とーアミノ基反応系
- -イソシアネート基と-水酸基反応系
- ーエポキシ基とーアミノ基反応系
- -カルボキシル基と-水酸基反応系
- 不飽和結合基と-ハロゲン基反応系
- カルボキシル基とーアミノ基反応系

[0064]

【発明の効果】

以上のように本発明では基板上への微粒子の固定を可能となり、生産性、耐久性、実用性で大幅な向上が期待できる。さらに、今後必要となる機能の特定などを実現するパターン形成も実現可能となり、これらの効果により、その工業的価値は大なるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施例での磁性微粒子の模式図

【図2】

第1の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図3】

第2の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図4】

第3の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図5】

第4の実施例の第一工程後の微粒子からなる構造体の模式図

【図6】

第4の実施例での最終工程後の微粒子からなる構造体の模式図

【図7】

第5の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図8】

第6の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図9】

第7の実施例での磁性微粒子の模式図

【図10】

第7の実施例での基板の模式図

【図11】

第7の実施例でのエネルギー線照射工程の模式図

【図12】

第7の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図13】

第8の実施例での微粒子からなる構造体の模式図

【図14】

第9の実施例での徴粒子からなる構造体の模式図

【符号の説明】

1, 10, 20, 30, 36, 50, 60, 72 微粒子

2, 4, 11, 13, 21, 23, 31, 33, 37, 51, 53, 61, 6

3, 66, 71, 73 单分子膜

3, 12, 22, 32, 52, 62, 80 基板

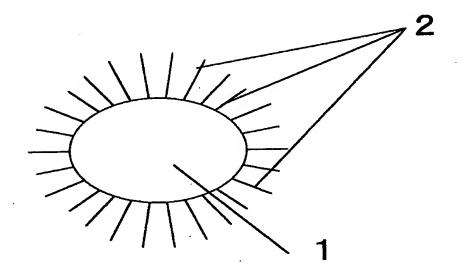
特2001-015380

- 5, 14, 24, 34, 38, 54, 67, 74 化学結合
- 6, 15, 25, 35, 39, 40, 70, 75 微粒子からなる構造物
- 64 高圧紫外線ランプ
- 65 金属マスク
- 81 微粒子からなる構造物のパターン

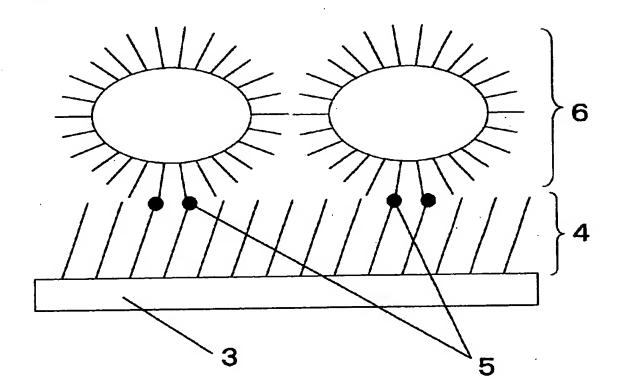
【書類名】

図面

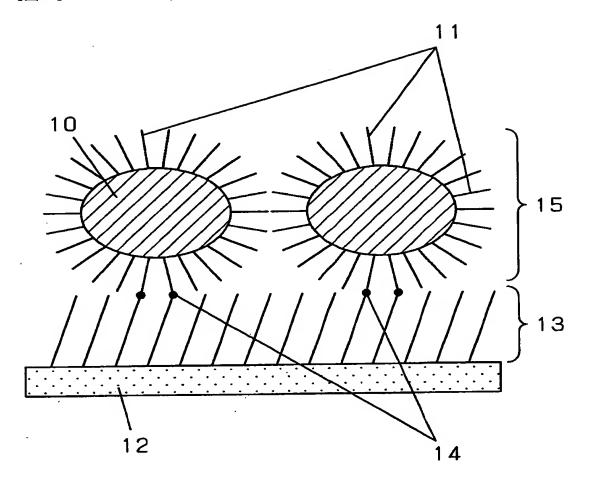
【図1】



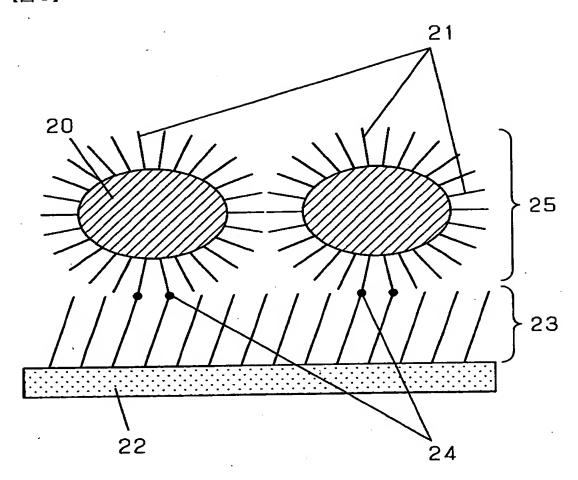
【図2】



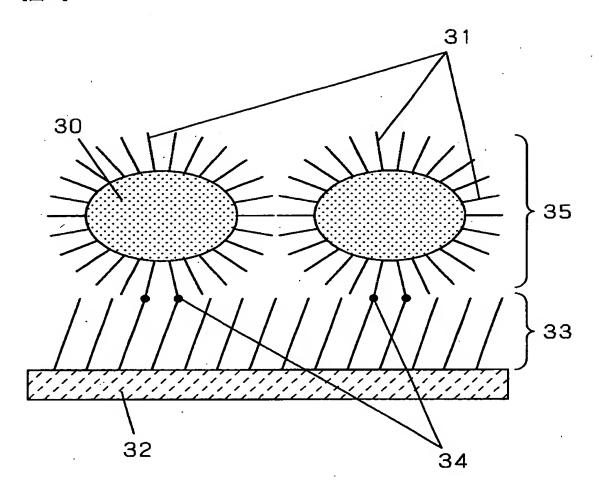
【図3】



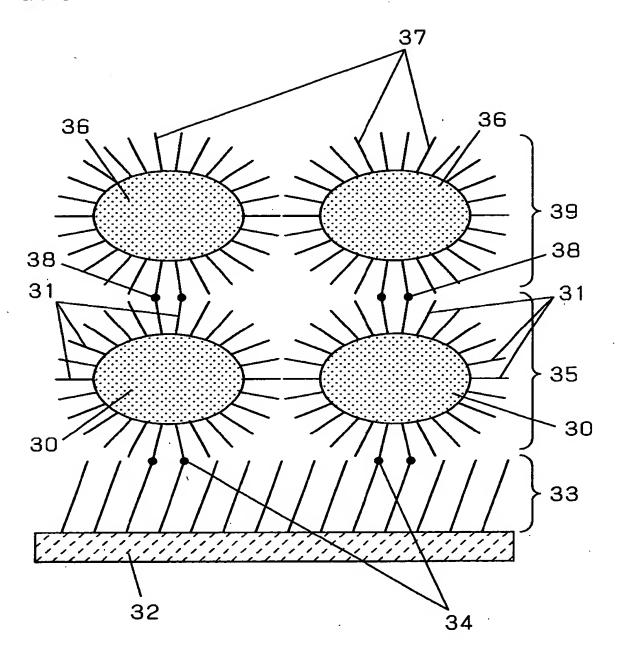
【図4】



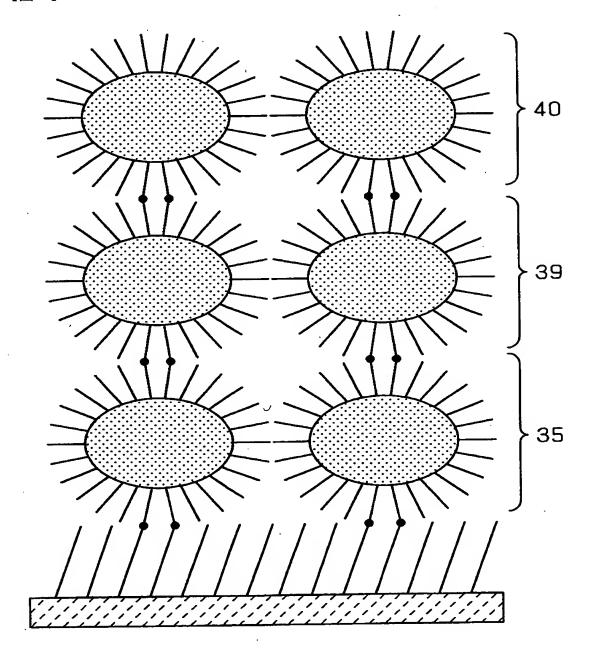
【図5】



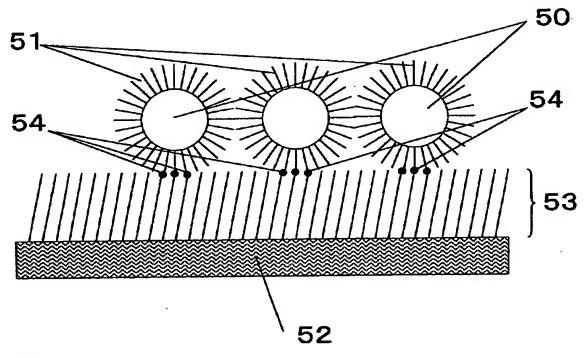
【図6】



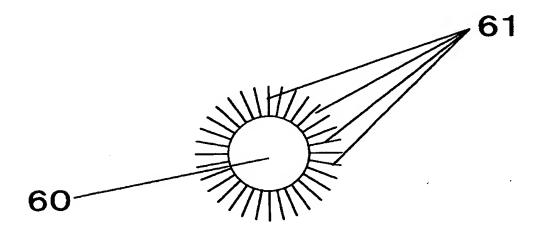
[図7]



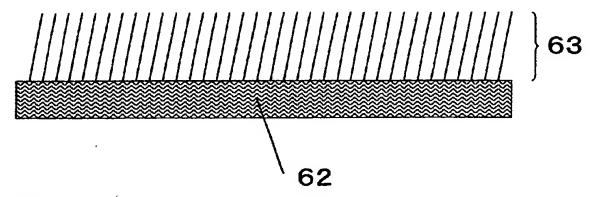




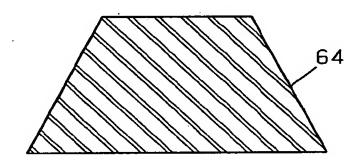
[図9]

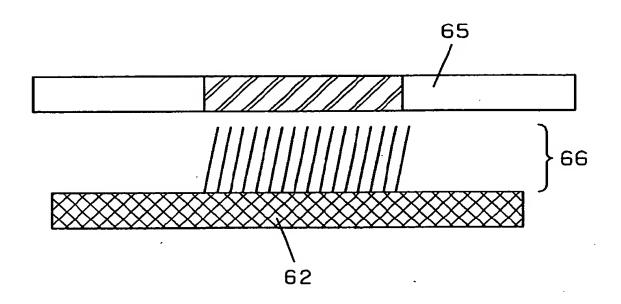


【図10】

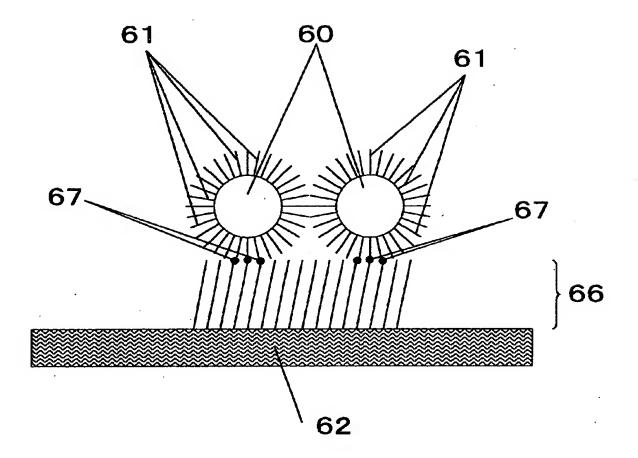


【図11】

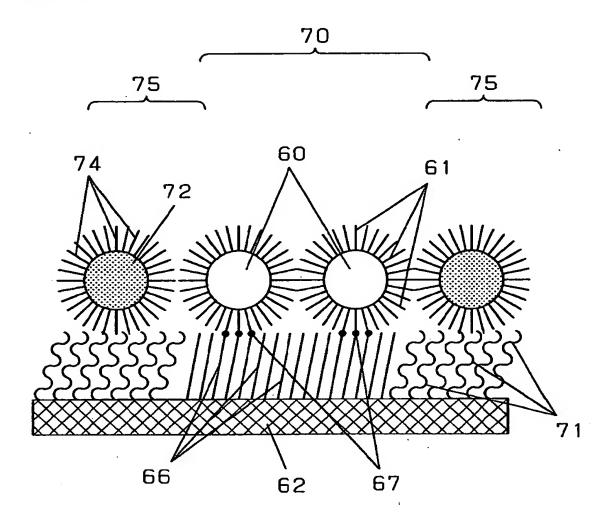




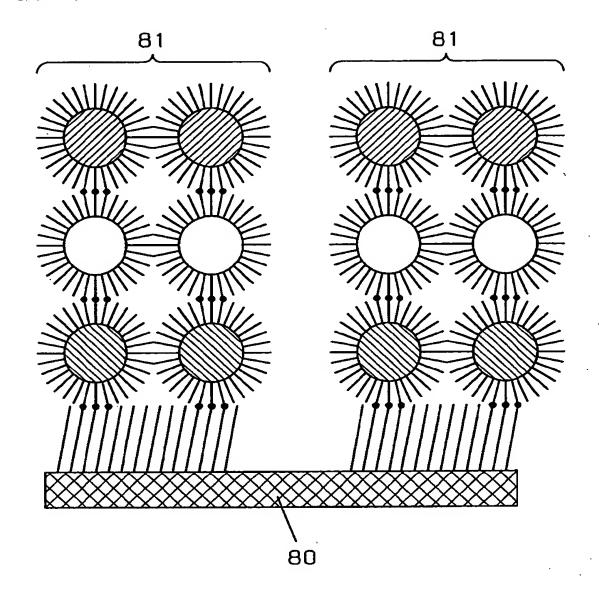
【図12】



【図13】



【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 微粒子径の単位で微粒子の膜厚を制御することができ、基板表面に 微粒子を均一に固定する方法を提供すること。

【解決手段】 微粒子からなる構造体を支持する基板と微粒子とをそれぞれに 形成した有機コーティング膜を介して化学結合を形成させ、固定化することで膜 厚分布を制御する。

【選択図】 図7

特2001-015380

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社